

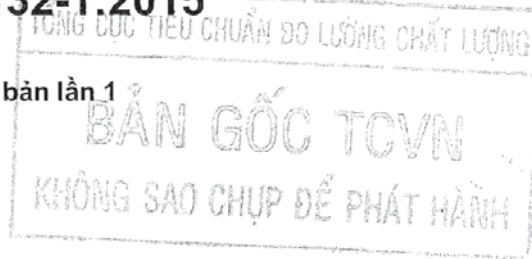
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11342-1:2016

IEC 62132-1:2015

Xuất bản lần 1



**MẠCH TÍCH HỢP –
ĐO MIỄN NHIỄM ĐIỆN TỪ –
PHẦN 1: ĐIỀU KIỆN CHUNG VÀ ĐỊNH NGHĨA**

Integrated circuits – Measurement of electromagnetic immunity –

Part 1: General conditions and definitions

HÀ NỘI – 2016

Mục lục

	Trang
Lời nói đầu	4
1 Phạm vi áp dụng	5
2 Tài liệu viện dẫn	5
3 Thuật ngữ và định nghĩa	6
4 Điều kiện thử nghiệm	10
5 Thiết bị thử nghiệm	11
6 Bố trí thử nghiệm	12
7 Quy trình thử nghiệm	14
8 Báo cáo thử nghiệm	17
Phụ lục A (tham khảo) – Bảng mô tả phương pháp thử nghiệm	19
Phụ lục B (tham khảo) – Mô tả chung về tấm mạch thử nghiệm	21
Thư mục tài liệu tham khảo	25

Lời nói đầu

TCVN 11342-1:2016 hoàn toàn tương đương với IEC 62132-1:2015;

TCVN 11342-1:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E3 *Thiết bị điện tử dân dụng* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 11342 (IEC 62132), Mạch tích hợp gồm các phần sau:

- 1) TCVN 11342-1:2016 (IEC 62132-1:2015), Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 1: Điều kiện chung và định nghĩa
- 2) TCVN 11342-2:2016 (IEC 62132-2:2010), Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 2: Đo miễn nhiễm bức xạ – Phương pháp buồng TEM và buồng TEM băng tần rộng
- 3) TCVN 11342-3:2016 (IEC 62132-3:2006), Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 3: Phương pháp bơm dòng điện lớn
- 4) TCVN 11342-4:2016 (IEC 62132-4:2006), Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 4: Phương pháp bơm trực tiếp công suất RF
- 5) TCVN 11342-5: 2016 (IEC 62132-5:2005), Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 5: Phương pháp lồng faraday trên bàn thử
- 6) TCVN 11342-8: 2016 (IEC 62132-8:2012), Mạch tích hợp – Phần 8: Đo miễn nhiễm điện từ – Phương pháp mạch dải IC
- 7) TCVN 11342-9:2016 (IEC 62132-9:2014), Mạch tích hợp – Phần 9: Đo miễn nhiễm bức xạ – Phương pháp quét bề mặt

Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ –

Phần 1: Điều kiện chung và định nghĩa

Integrated circuits – Measurement of electromagnetic immunity –

Part 1: General conditions and definitions

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin chung và các định nghĩa về phép đo độ miễn nhiễm điện từ của các mạch tích hợp (IC) đối với các nhiễu truyền dẫn và nhiễu bức xạ. Tiêu chuẩn này cũng quy định các điều kiện thử nghiệm chung, thiết bị thử nghiệm và cách bố trí, cũng như các qui trình thử nghiệm và nội dung của các báo cáo thử nghiệm của tất cả các phần của bộ tiêu chuẩn TCVN 11342 (IEC 62132). Các bảng so sánh các phương pháp thử nghiệm được bao gồm trong Phụ lục A nhằm giúp trong việc lựa chọn (các) phương pháp đo thích hợp.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi).

TCVN 11342-2 (IEC 62132-2), *Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 2: Đo miễn nhiễm bức xạ – Phương pháp buồng TEM và buồng TEM băng tần rộng*

TCVN 11342-3 (IEC 62132-3), *Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 3: Phương pháp bơm dòng điện lớn*

TCVN 11342-4 (IEC 62132-4), *Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 4: Phương pháp bơm trực tiếp công suất RF*

TCVN 11342-5 (IEC 62132-5), *Mạch tích hợp – Đo miễn nhiễm điện từ – Phần 5: Phương pháp lồng faraday trên bàn thử*

TCVN 11342-8 (IEC 62132-8), *Mạch tích hợp – Phần 8: Đo miễn nhiễm điện từ – Phương pháp mạch dải IC*

TCVN 11342-9 (IEC 62132-9), *Mạch tích hợp – Phần 9: Đo miễn nhiễm bức xạ – Phương pháp quét bề mặt*